

令和3年8月18日

「応用物理学会中国四国支部・若手半導体研究会」スケジュールについて

トピック: 応用物理学会中国四国支部・若手半導体研究会

時間: 2021年8月18日 12:30 PM 大阪、札幌、東京

Zoomミーティングによる。

聴講の問い合わせは

nokada@yamaguchi-u.ac.jp

までお願いします。

2021年度 応用物理学会中国四国支部 若手半導体研究会	
全体スケジュール	
8月23日(月)	
12:50 - 13:00	開会の言葉
13:00 - 13:30	特別講演 東北大学 小島一信 先生 『窒化物半導体の光学特性』
13:30 - 14:00	特別講演 東京大学 小林篤 先生 『窒化物半導体と超伝導体の融合をめざして』
	休憩
14:40 - 15:20	ポスターセッション 12件
	休憩
15:30 - 16:10	ポスターセッション 11件
	休憩
16:20 - 16:50	特別講演 大阪大学 谷川智之 先生 『窒化物半導体の波長変換デバイス応用』
16:50 - 17:20	特別講演 名古屋大学 本田善央 先生 『窒化物半導体のパワーデバイス応用とエピ・プロセス技術』
17:20 - 17:30	閉会の言葉

グループ1 前半			
1-1	古城 晴基	香川大学	GaAs内の強磁性Fe埋込み構造におけるパタン形状依存性
1-2	文谷 公亮	香川大学	SiN膜の N 2 アニール温度依存性の ESR および FTIR による評価
1-3	岡野昂輝	愛媛大学	ラビング処理によるナノワイヤ転写の表面観察
1-4	坂口健大	愛媛大学	2インチSi(111)基板上でのGaAsナノワイヤ分子線エピタキシャル成長
1-5	貞安朋樹	愛媛大学	AlGaOxナノワイヤ白色偏光特性の波長依存性
1-6	吉川晃平	愛媛大学	GaAs/GaNAsBiコーシェルナノワイヤの分子線エピタキシャル成長
1-7	東浦健人	愛媛大学	Bイオン注入ダイヤモンドの不純物分布に及ぼす超高压・高温処理の影響
1-8	稲山優斗	鳥取大学	GaAs基板上のワイドバンドギャップ半導体 ZnMgSTeの分子線 エピタキ シャル成長 と評価
1-9	辻 裕哉	鳥取大学	ZeSe系有機 無機ハイブリッド型紫外 APD アレイ の 開発
1-10	萩原 綱隆	鳥取大学	r 面サファイア上にMBE 成長したa 面ZnO:N 薄膜のポストアニール特性
1-11	富田敦之	徳島大学	気相反応を抑制した高温MOVPEにおけるV/III比依存性
1-12	津田 翔太	徳島大学	極性制御による高品質AlN成長手法の確立
グループ2 後半			
2-1	田村 元希	山口大学	r面サファイア加工基板上低温バッファー層のアニールによる結晶核形成
2-2	奥野 椋	山口大学	極小ピットを介したAlNテンプレートの高品質化
2-3	俵迫湧也	山口大学	完全緩和した{11-22}InGaN下地層上のInGaN/InGaN MQWに関する研究
2-4	小脇 岳土	山口大学	極小ピットを介したAlNテンプレート上AlGaInヘテロ構造の光学的特性
2-5	花咲光基	山口大学	N極性AlNの結晶成長の平坦性に及ぼすbuffer層のV/III比変化の影響
2-6	赤迫 瑞輝	岡山大学	水素処理した β Ga ₂ O ₃ のドナー密度の深さ分布と経時変化
2-7	岡村祐輝	広島大学	低温成長InAsBi/GaAs量子 構造の分子線エピタキシャル成長
2-8	池野雄貴	徳島大学	生体における2.45GHz帯無線電力伝送
2-9	神先雅也	徳島大学	サファイア基板上AlGaIn/GaN ノーマリオフ型トランジスタ
2-10	寺田唯人	岡山大学	多結晶Si 中準位に対するNi 拡散熱処理後冷却速度の影響
2-11	古賀 直弥	高知工科大学	Al 積層AZO 薄膜のその場熱処理による低抵抗化